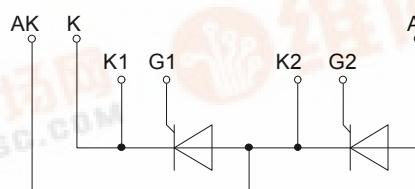
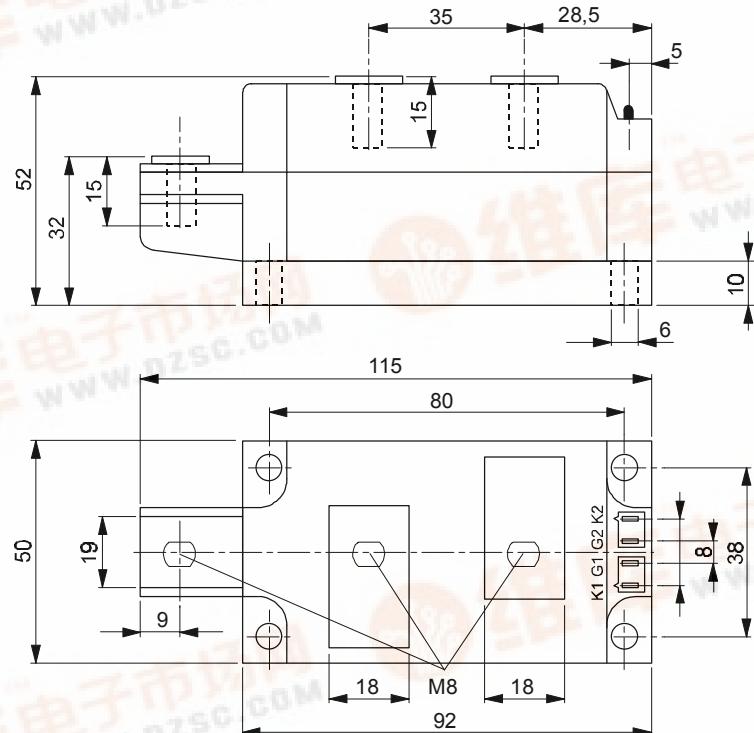




European Power-Semiconductor and Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information TT 250 N



TT 250 N, TD 250 N, DT 250 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties				
<i>Höchstzulässige Werte</i>		<i>Maximum rated values</i>				
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung		repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	600 1200 1400 1600 1800	V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung		non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{\text{DSM}} = V_{\text{DRM}}$		V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung		non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{\text{RSM}} = V_{\text{RRM}}$	+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert		RMS on-state current		I_{TRMSM}	410	A
Dauergrenzstrom		average on-state current	$t_c = 85^{\circ}\text{C}$ $t_c = 82^{\circ}\text{C}$	I_{TAVM}	250 261	A
Stoßstrom-Grenzwert		surge current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$	I_{TSM}	8000 7000	A
Grenzlastintegral		$\int i^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$	$\int i^2 dt$	320000 245000	A ² s
Kritische Stromsteilheit		current	$v_D \leq 67\%, V_{\text{DRM}}, f_0 = 50\ \text{Hz}$	$(di/dt)_{\text{cr}}$	150	A/ μ s
Kritische Spannungssteilheit		voltage	$v_L = 10\text{V}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,67\ V_{\text{DRM}}$	$(dv/dt)_{\text{cr}}$	1000	V/ μ s
<i>Charakteristische Werte</i>		<i>Characteristic values</i>				
Durchlaßspannung		on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 800\ \text{A}$	v_T	max.1,5	V
Schleusenspannung		threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(\text{TO})}$	0,8	V
Ersatzwiderstand		slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	r_T	0,7	m Ω
Zündstrom		gate trigger current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\ \text{V}$	I_{GT}	max. 200	mA
Zündspannung		gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\ \text{V}$	V_{GT}	max. 2	V
Nicht zündender Steuerstrom		gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6\ \text{V}$	I_{GD}	max.10	mA
Nicht zündende Steuerspannung		gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5\ V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max.0,2	V
Haltestrom		holding current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\ \text{V}, R_A = 5\ \Omega$	I_H	max. 300	mA
Einraststrom		latching current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\ \text{V}, R_{\text{GK}} >= 10\ \Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}, t_g = 20\ \mu\text{s}$	I_L	max.1,2	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom		forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = V_{\text{DRM}}, v_R = V_{\text{RRM}}$	i_D, i_R	max. 50	mA
Zündverzug		gate controlled delay time	$t_{vj}=25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max. 3	μ s
Freiwerdezeit		circuit commutated turn-off time	siehe Techn.Er./see Techn.Inf.	t_q	typ.250	μ s
Isolations-Prüfspannung		insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V_{ISOL}	3	kV
<i>Thermische Eigenschaften</i>		<i>Thermal properties</i>				
Innerer Wärmewiderstand		thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^{\circ}\text{el,sinus: pro Modul/per module}$ DC: pro Zweig/per arm	R_{thJC}	max.0,065	°C/W
			pro Modul/per module		max.0,13	°C/W
			pro Zweig/per arm		max.0,062	°C/W
					max.0,124	°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	heatsink		pro Modul/per module	R_{thCK}	max.0,02	°C/W
			pro Zweig/per arm		max.0,04	°C/W
Höchstzul.Sperrsichttemperatur		max. junction temperature	$t_{vj\ max}$		125	°C
Betriebstemperatur		operating temperature	$t_{c\ op}$		-40...+125	°C
Lagertemperatur		storage temperature	t_{stg}		-40...+130	°C
<i>Mechanische Eigenschaften</i>		<i>Mechanical properties</i>				
Gehäuse, siehe Seite		case, see page			1	
Si-Elemente mit Druckkontakt		Si-pellet with pressure contact				
Innere Isolation		internal insulation				
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung		mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse		terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2	12	Nm
Gewicht	weight			G	typ.	800 g
Kriechstrecke	creepage distance					17 mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz				5 . 9,81 m/s ²

Diese Module können auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.

These modules can also be supplied with common anode or common cathode.

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

TT 250 N

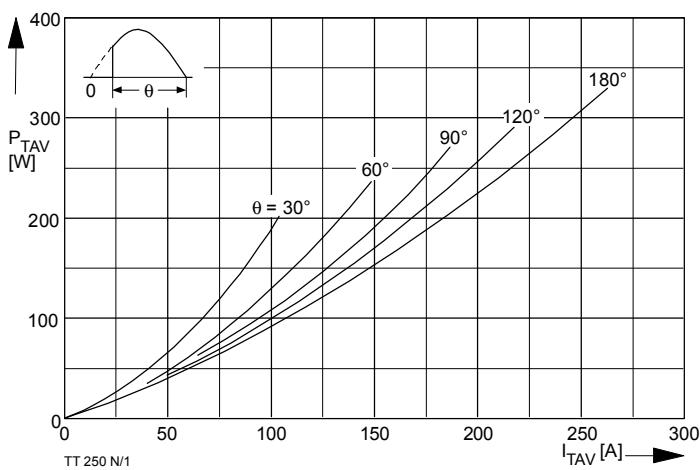


Bild / Fig. 1

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm

$$P_{TAV} = f(I_{TAVM})$$

Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

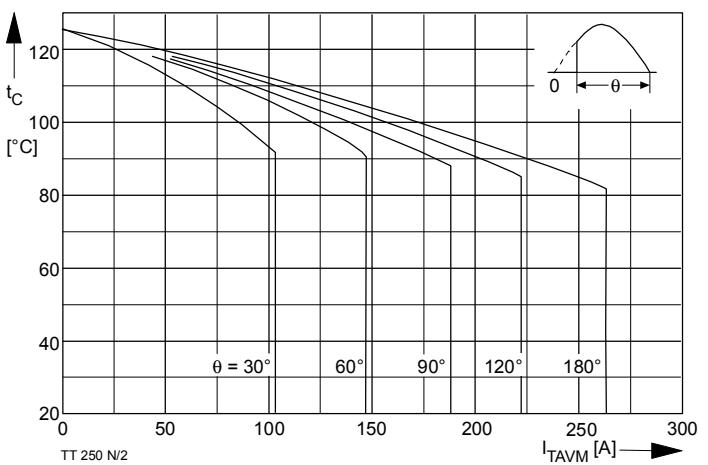


Bild / Fig. 2

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature

$$t_C = f(I_{TAVM})$$

Strombelastung je Zweig / current load per arm

Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

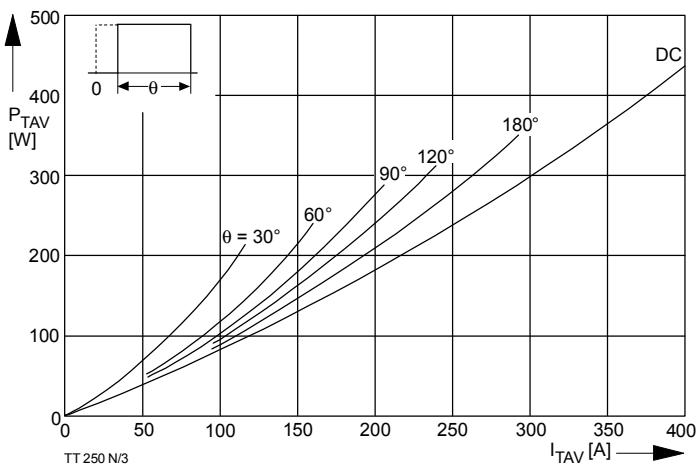


Bild / Fig. 3

Durchlaßverlustleistung eines Zweiges / On-state power loss per arm P_{TAV}

Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

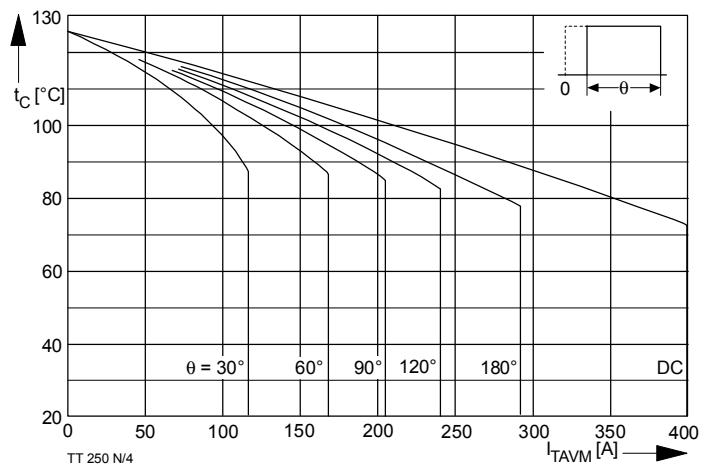


Bild / Fig. 4

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature

$$t_C = f(I_{TAVM})$$

Strombelastung je Zweig / current load per arm

Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

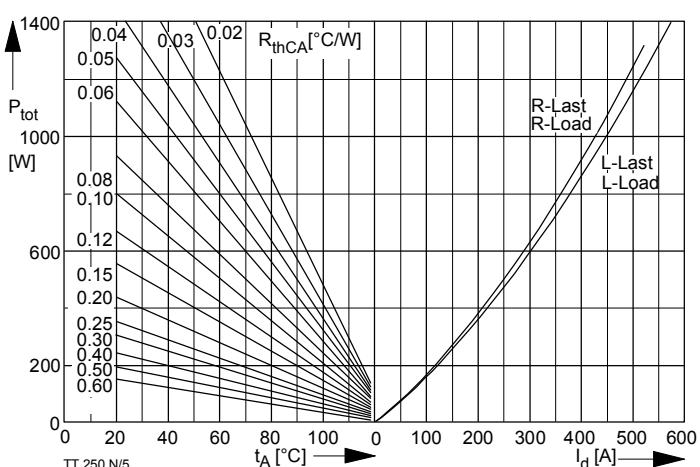


Bild / Fig. 5

B2 - Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d

Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}

Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

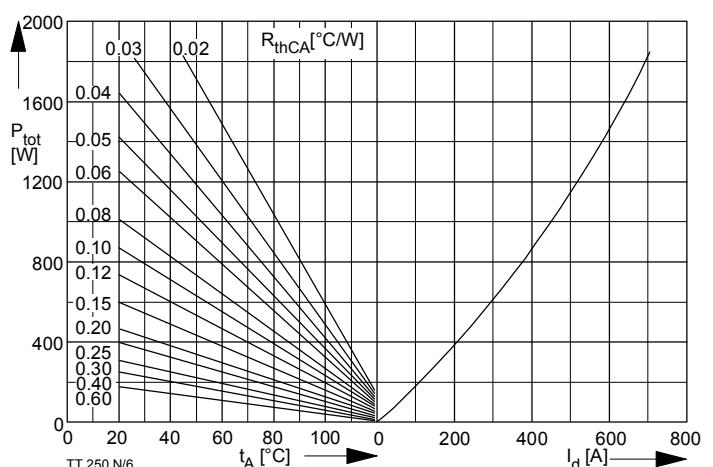


Bild / Fig. 6

B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d

Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}

Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

TT 250 N

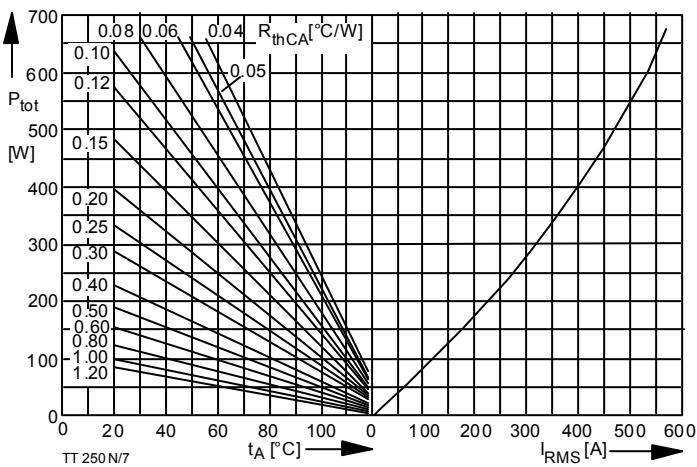


Bild / Fig. 7
W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

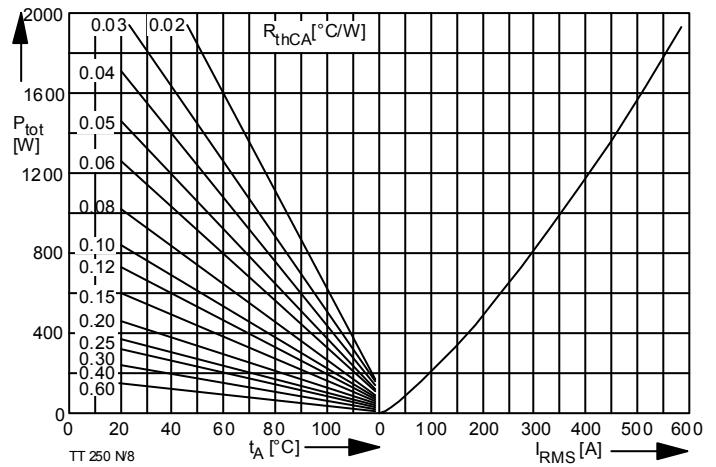


Bild / Fig. 8
W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum rated RMS current per phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

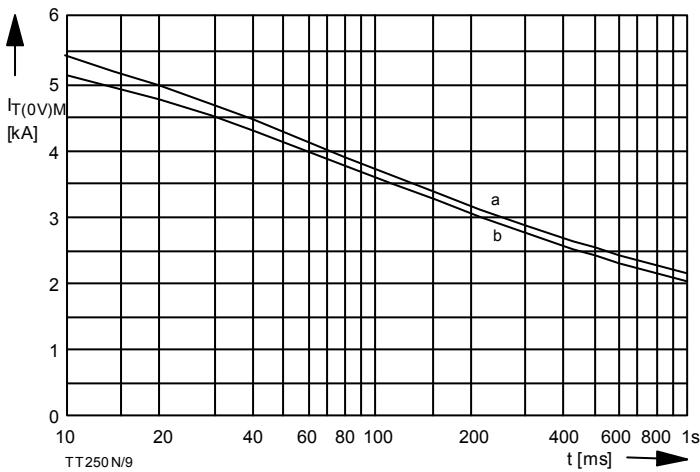


Bild / Fig. 9
Grenzstrom je Zweig ($0V$)_M. Belastung aus Leerlauf, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Maximum overload on-state current per arm $I_{T(0V)M}$: Surge current under no-load conditions, $V_R = 0,8 V_{RRM}$
a - $t_A = 35^\circ\text{C}$, verstärkte Lufthebung / forced cooling
b - $t_A = 45^\circ\text{C}$, Luftselbstkühlung / natural cooling

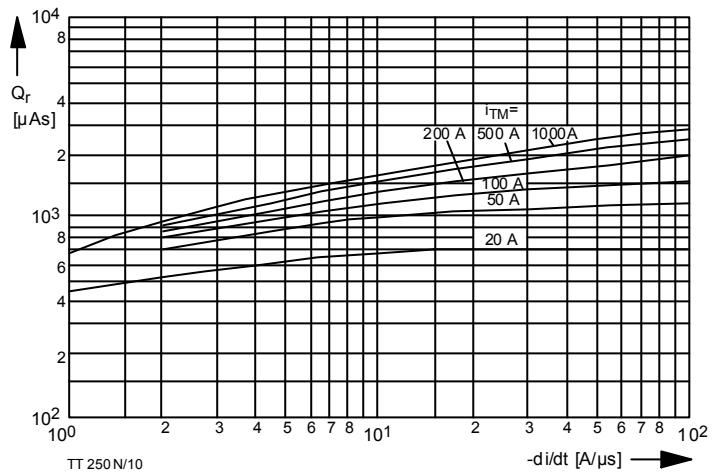


Bild / Fig. 10
Sperrverzögungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

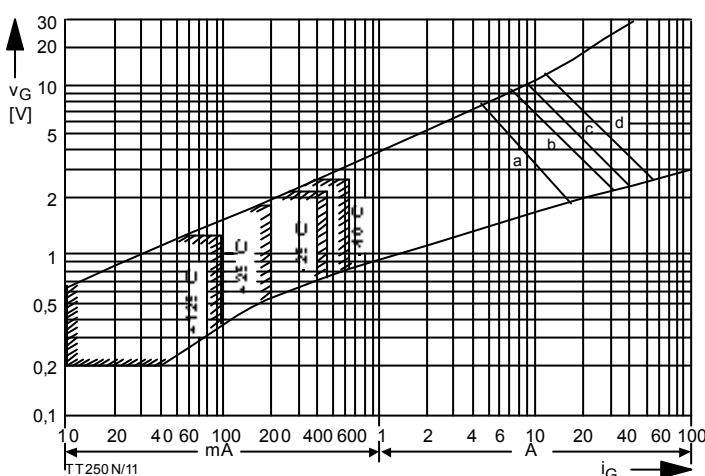


Bild / Fig. 11
Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, $v_G = f(i_G)$, $V_D = 6 \text{ V}$
Parameter:
a b c d
Steuerimpulsdauer / Pulse duration t_g [ms] 10 1 0,5 0,1
Höchstzulässige Spitzesteuerleistung /

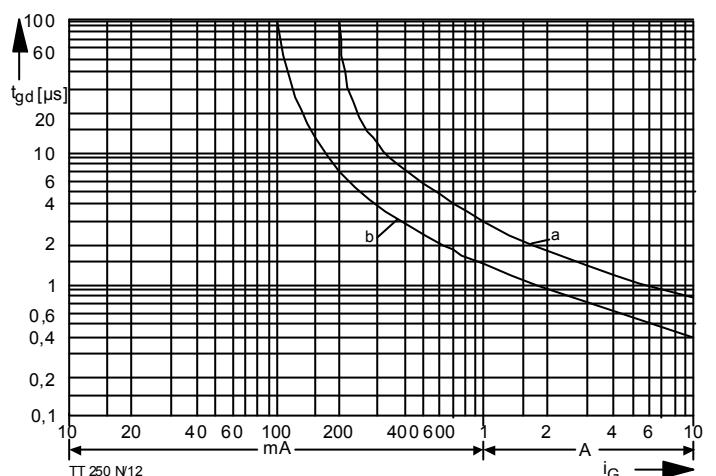


Bild / Fig. 12
Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_G)$
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$
a - äußerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic

TT 250 N

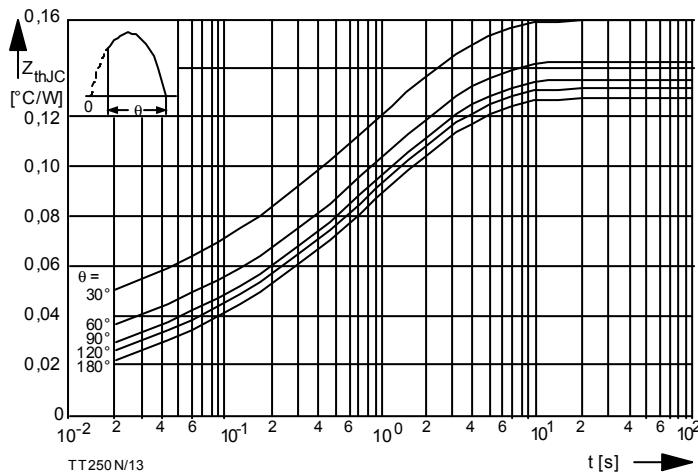


Bild / Fig. 13
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

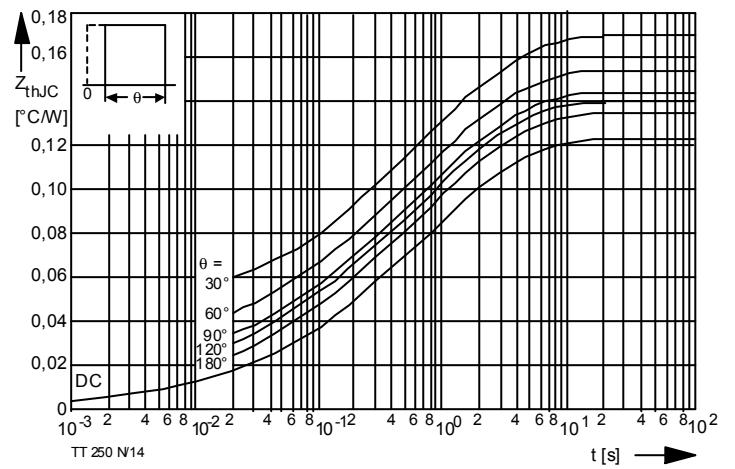


Bild / Fig. 14
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}\text{C}/\text{W}]$	0,0031	0,0097	0,0257	0,0429	0,0426		
$\tau_n [\text{s}]$	0,0009	0,008	0,11	0,61	3,06		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$